- 4 MAY 2003

中华人民共和国国家知识产权局

邮政编码:

香港湾仔港湾道 23 号鹰君中心 22 字楼 中国专利代理(香港)有限公司 杨凯,叶恺东





	杨 凯,叶信乐	不凡备法律效力)。						
	中 请 号: 99800377.8 部门及通知书类型: 3D	发文日期:						
	申 请 人: 精工爱普生株	式会社						
	发明名称: 半导体装置及其制造方法、中	自路基板和电子装置 发 安						
	第一次审查意见通知 (进入国家阶段的 PCT 申请	9952001						
1.	. 🔀 申请人提出了实审请求,根据专利法第 35 条第 L 款的规定,审查员							
_	□ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定,国家知识产权局决定自行对上述	4						
2.	2. 図 申请人要求以其在: 	·先权口,						
		先权日,						
		先权日,						
3.	3. □ 申请人提交的下列修改文件不符合专利法第 33 条的规定,因而不能	经接受:						
.,.	国际初步审查报告附件的中文译文。							
	□ 依据专利合作条约第 19 条规定所提交的修改文件的中文译文。	•						
□ 依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件。								
	□ 依据专利法实施细则第 51 条规定所提交的修改文件。							
	修改不能被接受的具体理由见通知书正文部分。							
4.	4. 🔀 审查是针对原始提交的国际申请的中文译文进行的。							
	□ 审查是针对下述申请文件进行的:							
	说明书 第页,按照原始提交的国际申请文件的中文译							
	第页,按照国际初步审查报告附件的中文译文							
	第页,按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条							
	第二二页,按照依据专利法实施细则第51规定所包							
	权利要求 第项,按照原始提交的国际申请文件的中文译 第项,按照依据专利合作条约第 19 条规定所提	·又: 與衣的修改文件的中文译文。						
	第项,按照限据专利合作录约第15 录然之所。第项,按照国际初步审查报告附件的中文译文							
	第项,按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条							
	The state of the s							
	第项,按照依据专利法实施到则第 51 录从足							

第____页,按照原始提出的国际申请文件的中文译文:

__页,按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条所提交的修改文件; __页,按照依据专利法实施细则第 51 条规定所提交的修改文件。

第____页。按照国际初步审查报告附件的中文译文:

附图

5. 🔀 本通知书引用下述对比文献 (其编号在今后的审查过程中继续沿用):

☑ 引用的对比文件的复印件共 <u>1</u> 份 <u>7</u> 页。

编号	文件号或名称	公 开 日 期 (或抵触申请的申请日)	
1	<u>US 5, 683, 942</u>	<u>1997</u> 年 <u>11</u> 月 <u>4</u> 日	
2		年 _ 月 _ 日	
3		年月日	
4		年月日	

L	3	年	月	日
	4	年	月	日
6.	审查的结论性意见:			
	 ★子权利要求书: 収利要求属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。 权利要求不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。 权利要求 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 38, 43, 46, 49, 52 不具备专利法第 2	22 条第 3 款規	! 定的创造	锋。
7.	基于上述结论性意见,审查员认为: 申请人应按照通知书正文部分提出的要求,对申请文件进行修改。 申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由,并对通知定之处进行修改,否则将不能授予专利权。 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容,如果申请人没有陈述理由或被驳回。			
8.	申请人应注意下述事项: (1) 根据专利法第 37 条的规定,申请人应在收到本通知书之日起的 <u>肆</u> 个月内当理由逾期不答复,其申请将被视为撤回。 (2) 申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定,修改文本应一式两份,关规定。 (3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交给中国专利局受理处,凡未不具备法律效力。 (4) 未经预约,申请人和/或代理人不得前来中国专利局与审查员举行会晤。	其格式应符合	审查指南	有的有
9.				

第一次审查意见通知书正文

- 1. 独立权利要求 6 所要求保护的技术方案不具备专利法第 22 条第 3 款规定的新颖性。对比文件 1 (US 5,683,942)公开了一种半导体器件,并具体公开了以下内容(参见第 3 栏 41 行-第 4 栏 48 行,图 5A):具有贯通孔的绝缘膜3;具有电极焊盘2的芯片1;位于绝缘膜3上的导电层6,通过粘结层22 粘结到芯片1;由焊料制成的突点9通过贯通孔中的导电部件4与导电层6电连接;突点9的直径等于贯通孔的直径。独立权利要求6与对比文件1的不同之处在于:a)半导体元件形成在基板,而不是绝缘膜上,然而半导体元件能形成在绝缘膜上也同样能形成在基板上,况且本申请的实施例1和2中也采用了绝缘膜;b)贯通孔突出部的直径不仅等于还小于贯通孔的直径,然而在工艺上稍做变化,本领域的技术人员能很容易将突点9做得较小。因此,独立权利要求6不具备创造性。
- 2. 从属权利要求 9 和 12 的附加技术特征涉及基板是绝缘基板或印刷基板,这两种基板都是最常见的基板形式,因此从属权利要求 9 和 12 依然不具备创造性。
- 3. 从属权利要求 15 的附加技术特征涉及外部电极由焊锡形成,然而对比文件 1 中的突点同样由焊料制成,因此从属权利要求 15 仍然不具备创造性。
- 4. 从属权利要求 18 的附加技术特征涉及基板比半导体元件大,然而将基板制作得与半导体元件同样大或比半导体元件大,都是很容易做到的,仅取决于器件设计要求,因此从属权利要求 18 同样不具备创造性。
- 5. 从属权利要求 21 的附加技术特征涉及半导体元件的电极通过各向异性导电材料与导电部件电连接,然而这种导电部件之间的电连接方式也是本领域中经常采用的电连接方式,因此从属权利要求 21 还是不具备创造性。
- 6. 从属权利要求 24 的附加技术特征涉及半导体元件通过引线与导电部件电连接,然而无论是倒装芯片的焊料突电电连接还是芯片主表面朝上的引线键合电连接通常本领域中常见芯片和外部的电连接法,因此从属权利要求 24 也不具备创造性。
 - 7. 独立权利要求 27 涉及安装了权利要求 6、9、12、15、18、21、24 任

一项中的半导体装置,由于所述的权利要求均不具备创造性,因此独立权利要求 27 同样不具备创造性。

- 8. 独立权利要求 30 涉及具有权利要求 27 的电路基板的电子装置,由于权利要求 27 不具备备创造性,因此独立权利要求 30 同样不具备创造性。
- 9. 独立权利要求 38 所要求保护的技术方案不具备专利法第 22 条第 3 款规定的新颖性。对比文件 1 (US 5,683,942) 公开了一种半导体器件,并具体公开了以下内容 (参见第 4 栏 57-第 6 栏 30 行,图 6-8): 在膜载体 30 上形成导电层 60 和通孔; 将导电层 60 与芯片 1 电连接; 由焊料制成的突点 9 形成在贯通孔中的导电部件 4 上; 突点 9 的直径等于贯通孔的直径。独立权利要求 38 与对比文件 1 的不同之处在于: a) 半导体元件形成在基板,而不是绝缘膜上,然而半导体元件能形成在绝缘膜上也同样能形成在基板上,况且本申请的实施例 1 和 2 中也采用了绝缘膜; b) 贯通孔突出部的直径不仅等于还小于贯通孔的直径,然而在工艺上稍做变化,本领域的技术人员能很容易将突点 9 做得较小。因此,独立权利要求 38 不具备创造性。
- 10. 从属权利要求 43 的附加技术特征涉及外部电极由焊锡形成,然而对比文件1中的突点同样由焊料制成,因此从属权利要求 43 仍然不具备创造性。
- 11. 从属权利要求 46 的附加技术特征也被对比文件 1 公开了,参见图 7G 和第 6 栏 14-18 行,因此从属权利要求 46 依然不具备创造性。
- 12. 从属权利要求 49 和 52 的附加技术特征与从属权利要求 21 和 24 的附加技术特征基本相同,因此基于同样的理由,从属权利要求 49 和 52 同样不具备创造性。

基于上述理由,以现在的文本还不能授予专利权。如果申请人按照本通知书提出的审查意见对申请文本进行修改,克服所存在的缺陷,则有助于加快本案的审查进程。请申请人注意,对申请文件的修改应当符合中国专利法第 33 条的规定,不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

审查员: